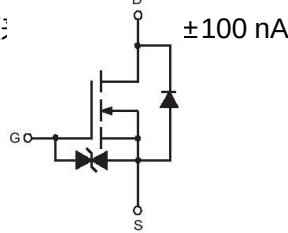


/ Revised record

版本	修订日期	有修订的页码	修订涉及的内容	拟制	审核
F		2017-4			
G	1.2	2018-12	按客户要求，修改等效电路图及参数 I_{GSS} 由原来 ± 100 nA 改为 ± 10 uA	蓝月葵	刘晓荣
H	1.2	2021-5-28	修改为不带等效电路及参数 I_{GSS} 由原:  ± 100 nA	黄超	庞隆基
I	2021-8-31	1	特征栏增加无卤标示做无卤规格书	陆丽英	刘晓荣
J	2021-11-15	2	增加 C_{ISS} 、 C_{OSS} 、 C_{RSS} 参数	黄超	庞隆基
A	2022-4-23	all	型号加 BR/Q，特征及应用增加汽车产品描述（符合 AEC-Q101 标准高可靠性要求、满足汽车应用的严格要求），印章 H 改为 Q，峰值温度 245 ± 5 ，时间持续为 5 ± 0.5 sec 更新为：峰值温度 255 ± 5 ，时间持续为 5 ± 0.5 sec。	黄超	庞隆基

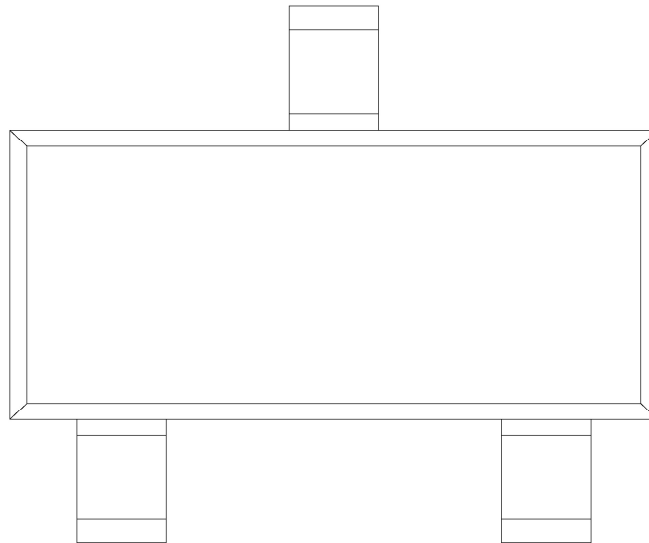
SOT-23 塑封封装 N 沟道 MOS 场效应管。N-CHANNEL MOSFET in a SOT-23 Plastic Package.

输出电阻小、性能高；SOT-23 封装，利于设计安装，符合 AEC-Q101 标准高可靠性要求，无卤产品。
Low $R_{DS(on)}$, rugged and reliable, compact industry standard SOT-23 surface mount pac) ac) p

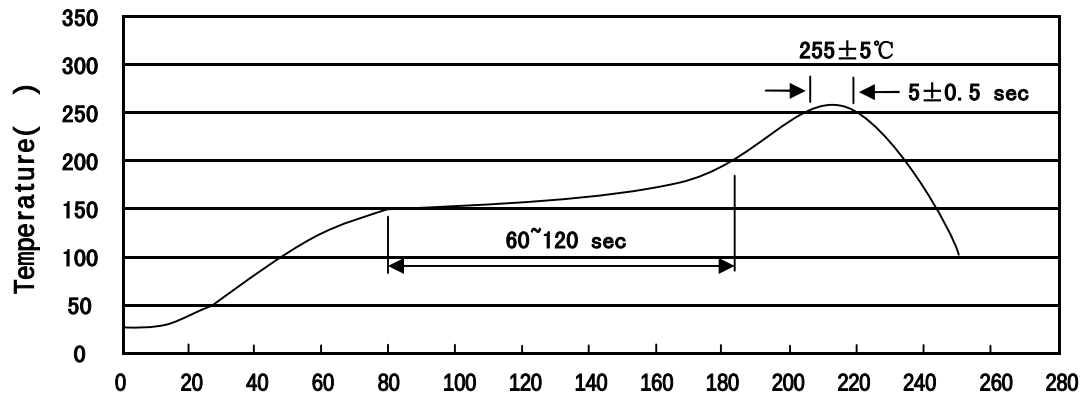
参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Drain-Source Voltage	V_{DSS}	50	V ⁷
Gate-Source Voltage	V_{GSS}	±20	V
Drain Current	I_D	220	mA
Peak Drain Current	I_{DM}	880	mA
Power Dissipation	P_D	360	mW

Thermal Resistance, Junction-to-

/ Marking Instructions



() / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



说明：

- 1、预热温度 150 ~ 200℃，时间 60 ~ 120sec；
- 2、峰值温度 255±5℃，时间持续为 5±0.5sec；
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10℃/sec.

Note:

- 1.Preheating:150~200℃, Time:60~120sec.
- 2.Peak Temp.:255±5℃, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10℃/sec.

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5℃

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5℃

Time:10±1 sec

/ Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type	Units					Dimension (unit mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box	Outer Box
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7" ×8	180×120×180	390×385×205

/ Notices